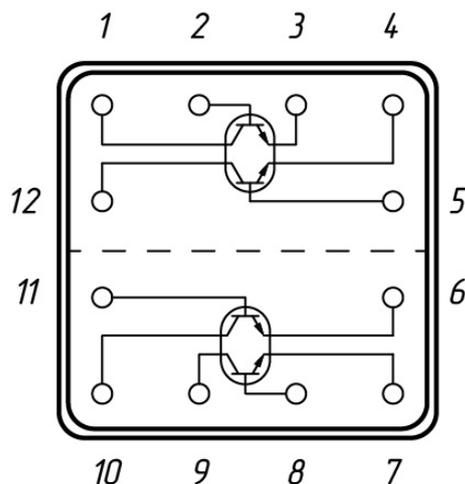


Транзисторная сборка КТ365СА/Б

Транзисторная сборка КТ365СА/Б содержит две отдельных кремниевых бескорпусных пары планарных транзисторов n-p-n-структуры. Низкая стоимость и отличные характеристики транзисторов позволяют эффективно использовать сборку в различных радиоэлектронных устройствах, работающих в диапазоне до 250 МГц. Конструктивно она оформлена в металлополимерном корпусе с 12 выводами. Габаритные размеры корпуса: 11,6x11,6x5 мм, масса 1,5 г. Транзисторная сборка КТ365СА/Б выпускается для замены устаревшей микросхемы 1ММ6.0.

Цоколевка



Основные электрические параметры

Параметр	Подгруппа А	Подгруппа Б	Ед. изм.
Статический коэффициент передачи	40...250	40...250	
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте не менее	2,5	2,5	
Обратный ток коллектора не более	300	300	нА
Обратный ток эмиттера не более	600	600	нА
Емкость коллекторного перехода	6	6	пФ
Емкость эмиттерного перехода	7	7	пФ
Ток утечки между коллекторами не более	50	—	нА
Отношение статических коэффициентов передачи тока, не менее	0,7	—	
Прямое падение напряжения эмиттер-база	0,5...1,0	—	В
Разность прямых падений напряжений эмиттер-база различных транзисторов микросхемы, не более	0,1	—	В

Предельные эксплуатационные данные

Параметр	Значение	Ед. изм.
Максимальное допустимое напряжение коллектор-база	10	В
Максимальное допустимое напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер не более 3 кОм	10	В
Максимальное допустимое напряжение эмиттер-база	4	В
Максимальный допустимый ток коллектора (эмиттера)	20	мА
Максимальная допустимая импульсная и постоянная мощность, рассеиваемая транзистором при температуре $55 \pm 5^\circ\text{C}$,	15	мВт

Чертеж корпуса

Металлополимерный корпус «Тропа» (2МС12-1)

